

СПИСОК  
научных и учебно-методических работ

Турин Валентин Олегович

№ п/п	Наименование работы, ее вид	Форма работы	Выходные данные	Объем в п.л. или с.	Соавторы
1	Photocounts and the catastrophe theory, (тезисы).	печатная ИСТ в Ф	<i>International Conference "Quantum optics"</i> , Davos, Switzerland, (1994)	1 с.	V.P. Bykov, A.V. Gerasimov, V.O. Turin
2	An alternative approach to the theory of photocounts, (статья).	печатная ИСТ Ф	<i>Laser Physics</i> , Vol. 5, No. 4, pp. 841-851, (1995)	10 с.	V.P. Bykov, A.V. Gerasimov, V.O. Turin
3	Кулоновская дезынтеграция слабых электронных потоков и фотоотсчеты, (статья).	печатная ИСТ в Ф	Успехи физических наук (Physics-Uspekhi), 165, №8, 955-966, (1995)	11 с.	В.П. Быков, А.В. Герасимов, В.О. Турин
4	Photocounts and the catastrophe theory, (статья).	печатная ИСТ в Ф	<i>Annales de la foundation Louis de Broglie</i> , Vol.20, No.3, pp. 331-357, (1995)	26 с.	V.P. Bykov, A.V. Gerasimov, V.O. Turin
5	Электронные волновые пакеты в вакуумных фотоприемниках и возможность их наблюдения, (статья).	печатная ИСТ в Ф	Письма в ЖЭТФ (JETP Letters), 63, № 6, 408-411, (1996)	4 с.	В.П. Быков, А.М. Прохоров, В.О. Турин, С.Л. Чин
6	Неустойчивость многоэлектронной системы и фотоотсчеты, (тезисы).	печатная ИСТ в Ф	XXXIX научная конференция МФТИ, Долгопрудный (1996)	1 с.	В.П. Быков, В.О. Турин
7	Неустойчивость многоэлектронной системы и фотоотсчеты, (статья).	печатная ИСТ в Ф	Материалы XXXIX научной конференции МФТИ (1996)	5 с.	В.П. Быков, В.О. Турин
9	The motion of electron wave packets in vacuum devices and the sharpening of these wave packets due to coulomb interaction, (статья).	печатная ИСТ в Ф	<i>Laser Physics</i> , Vol. 7, No.4, pp. 984-988, (1997)	4 с.	V.P. Bykov, V.O. Turin,
10	Электростатическая	печатная	XL научная	1 с.	В.П. Быков, В.О.

	дефокусировка одноэлектронных волновых пакетов, (тезисы).	нет 6 Ф	конференция МФТИ, Долгопрудный (1997)		Турин
11	Электростатическая дефокусировка одноэлектронных волновых пакетов, (статья).	печатная нет 6 Ф	Материалы XL научной конференции МФТИ (1997)	5 с.	В.П. Быков, В.О. Турин
12	Динамика электронных пакетов. Макроскопические одноэлектронные волновые пакеты, (тезисы).	печатная нет 6 Ф	3-ий Всероссийский семинар "Проблемы теоретической и прикладной электронной оптики" Москва, (1998)	1 с.	В.П. Быков, В.О. Турин
13	Новый вид волнового пакета - обобщение когерентного состояния осциллятора, (тезисы).	печатная нет 6 Ф	3-ий Всероссийский семинар "Проблемы теоретической и прикладной электронной оптики" Москва, (1998)	1 с.	В.О. Турин
14	Динамика электронных пакетов. Макроскопические одноэлектронные волновые пакеты, (статья).	печатная нет 6 Ф	Прикладная физика, № 2, 46-65, (1998)	9 с.	В.П. Быков, В.О. Турин
15	Новый вид волнового пакета - обобщение когерентного состояния осциллятора, (статья).	печатная нет 6 Ф	Прикладная физика, № 2, 65-77, (1998)	3 с.	В.О. Турин
16	New type of the wave packet - generalization of the oscillator coherent state, (тезисы).	печатная нет 6 Ф	7th Int. Seminar on Quantum Optics, Raubichi, Belarus, (1998)	1 с.	V.O. Turin
17	Electrostatic defocusing of one-electron wave-packets, (статья).	печатная нет 6 Ф	Laser Physics, Vol. 8, No. 5, pp. 1039-1043, (1998)	5 с.	V.P. Bykov, V.O. Turin
18	Dynamics of electron packets and photocounts, (статья).	печатная нет 6 Ф	SPIE Proceedings, Vol. 3736, pp. 151-168, (1999)	18 с.	V.P. Bykov, V.O. Turin,
19	Сжатые состояния, маятник Капицы и макроскопические	печатная нет 6 Ф	XLIII научная конференция МФТИ, Долгопрудный (2000)	1 с.	В.О. Турин

	волновые пакеты, (тезисы)				
20	Wave packets, squeezed states and uncertainty relation, (тезисы).	печатная V.O. P	8th Int. Seminar on Quantum Optics, Raubichi, Belarus, (2000).	1 с.	V.O. Turin
21	Wave packets, squeezed states and uncertainty relation, (тезисы).	печатная V.O. P	XXIII International Colloquium on Group Theoretical Methods in Physics, Dubna, Russia, (2000).	1 с.	V.O. Turin
22	Analysis of the radio-frequency single-electron transistor with large quality factor, (статья).	печатная V.O. P	Applied Physics Letters, Vol. 83, No. 14, pp. 2898-2900, (2003)	3 с.	V.O. Turin, A.N. Korotkov
23	Analysis of the radio-frequency single-electron transistor with large quality factor, (статья).	компьютерная V.O. P	Virt. J. Nanoscale Sci. & Tech., Vol. 8, No. 15, (2003) (Selected from APL).	3 с.	V.O. Turin, A.N. Korotkov
24	Performance degradation of GaN field-effect transistors due to thermal boundary resistance at GaN/substrate interface, (статья).	печатная V.O. P	Electronics Letters, Vol. 40, No. 1, pp. 81-82, (2004).	2 с.	V.O. Turin, A.A. Balandin
25	The ambient temperature effect on current-voltage characteristics of surface-passivated GaN-based field-effect transistors, (статья).	компьютерная V.O. P	MRS Internet J. Nitride Semicond. Res. 9, 7 (2004).	5 с.	W.L. Liu, V.O. Turin, A.A. Balandin, Y.L. Chen, K.L. Wang
26	Numerical analysis of radio-frequency single-electron transistor operation, (статья).	печатная V.O. P	Physical Review B, Vol. 69, pp. 195310-1-13, (2004).	13 с.	V.O. Turin, A.N. Korotkov
27	A modified transferred-electron high-field mobility model for GaN devices simulation, (статья).	печатная V.O. P	Solid-State Electronics, Vol. 49, No. 10, pp. 1678-1682, (2005).	5 с.	V.O. Turin
28	Simulation of self-heating and ambient temperature effects in GaN-based field-effect transistors, (тезисы).	печатная V.O. P	FF13.5, 2005 MRS Fall Meeting, Boston, MA, USA, (2005).	1 с.	V.O. Turin and A.A. Balandin

29	Simulation of self-heating and temperature effect in GaN-based metal-semiconductor field-effect transistor, (статья).	печатная нет Ф	<i>MRS Symposium Proceedings</i> , Vol. 892, FF13-05, (2006).	3 с.	V.O. Turin, A.A. Balandin
30	Compact Iterative Field Effect Transistor Model, (тезисы).	печатная нет Ф	<i>NSTI-Nanotech 2006</i> , ISBN 0-9767985-8-1 Vol. 3, pp. 648-651, (2006).	4 с.	M.S. Shur, V.O. Turin, D. Veksler, T. Ytterdal, B. Iñiguez and W. Jackson
31	Simulations of gate-recessed and field-plated AlGaIn-GaN heterojunction field-effect transistors, (тезисы).	печатная нет Ф	<i>2006 Lester Eastman Conference on High Performance Devices</i> , Cornell University, Ithaca, NY, USA (2006).	1 с.	V.O. Turin, M.S. Shur, and D.B. Veksler
32	Electrothermal simulation of the self-heating effects in GaN-based field-effect transistors, (статья).	печатная нет Ф	<i>Journal of Applied Physics</i> , Vol. 100, pp. 054501-1-8, (2006).	8 с.	V.O. Turin, A.A. Balandin,
33	Universal TFT Compact Model, (тезисы).	печатная нет Ф	210th Meeting of Electrochemical Society, Cancun, Mexico, (2006).	1 с.	B. Iniguez, M. Shur, V. Turin, D. Veksler, T. Ytterdal and W. Jackson,
34	Simulations of field-plated and recessed gate Gallium Nitride – based heterojunction field-effect transistors, (статья).	печатная нет Ф	<i>International Journal of High Speed Electronics and Systems</i> , Vol. 17, No. 1, pp. 19-23, (2007).	5 с.	V.O. Turin, M.S. Shur, and D.B. Veksler
35	Simulations of field-plated and recessed gate Gallium Nitride – based heterojunction field-effect transistors, (статья).	печатная нет Ф	"Selected Topics in Electronics and Systems" - Vol. 45 ADVANCED SEMICONDUCTOR DEVICES, Proceedings of the 2006 Lester Eastman Conference (2007).	5 с.	V.O. Turin, M.S. Shur, and D.B. Veksler
36	Автоматизация изучения свойств ферромагнетиков с использованием среды LabVIEW, (тезисы).	печатная нет Ф	Международная научно-методическая школа-семинар по проблеме "Физика в системе инженерного образования стран ЕвразЭС", МАИ-МФТИ, г. Москва, 25-	2 с.	Турин В.О., Рогожина Т.С., Рогожин М.Н.

			27 июня 2007.		
37	Моделирование вертикального кремниевого МОП-транзистора с двойной диффузией, (тезисы).	печатная КСГ 6 Ф	Международная конференция " Микро- и наноэлектроника", МИЭТ, Зеленоград, 2008.	1 с.	А.В. Седов, А.М. Цырлов, В.О. Турин
38	Моделирование частотных характеристик AlGaIn-GaN полевого транзистора с 150 нм затвором, (тезисы).	КСГ 6 Ф	I Всероссийская конференция ММПСН-2008 «Многомасштабное моделирование процессов и структур в нанотехнологиях», НИЯУ "МИФИ" 12-14 марта 2008.	1 с.	Турин В.О., Шур М.С., Векслер Д.Б.
39	Моделирование кремниевого МОП транзистора в симуляторах цепей типа SPICE и в программе приборно-технологического моделирования типа TCAD с использованием стандартной компактной модели транзистора и дрейфово-диффузионной модели полупроводника, (отчет).	печатная	Договор ОрелГТУ - ОАО "Протон" № 130/4-07, (2008).  КСГ 6 Ф	50 с.	В.О. Турин, А.В. Седов, Г.И. Зебрев, А.М. Цырлов
40	Корректный учёт короткоканальных эффектов и точный учёт сопротивлений истока и стока в компактной модели TFT транзистора, (тезисы).	печатная КСГ 6 Ф	Конференция ММПСН-2009 Секция 1 «Моделирование явлений в наноэлектронике, фотонике, магнитных и сверхпроводящих структурах», НИЯУ МИФИ, г. Москва, 05.05.2009.	2 с.	В.О. Турин, А.В. Седов, Г.И. Зебрев, Б. Инигез, М.С. Шур
41	Extrinsic Compact MOSFET Model with Correct Account of Positive Differential Conductivity after	печатная КСГ 6 Ф	Международная конференция "Микро- и наноэлектроника - 2009" (МНЭ-2009).	1 с.	V.O. Turin, A.V. Sedov, G.I. Zebrev, B. Iñiguez, and M.S. Shur

	Saturation, (тезисы).				
42	SPICE Modeling and TCAD Simulation of Si Vertical Double-Diffused MOSFET, (тезисы).	КС 6 0	Международная конференция "Микро- и нанoeлектроника - 2009" (МНЭ-2009).	1 с.	A.V. Sedov, V.O. Turin, A.M. Tsyrllov, and G.I. Zebrev
43	Intrinsic compact MOSFET model with correct account of positive differential conductance after saturation, (статья).	печатная КС 6 0	Proc. SPIE 7521, 75211H, pp. 1-9, (2009)	9 с.	V.O. Turin, A.V. Sedov, G.I. Zebrev, B. Iniguez, and M.S. Shur
44	Improvements to $\alpha$ -Si RPI-TFT model: now extrinsic and with correct account of the positive differential conductivity after saturation, (тезисы).	печатная КС 6 0	MOS-AK Workshop, Athens, Greece, 18 Sept. 2009.	1 с.	V.O. Turin, A.V. Sedov, G.I. Zebrev, B. Iniguez, and M.S. Shur
45	Приборно-технологическое моделирование тепловых и частотных режимов работы GaN полевых транзисторов и компактное моделирование с корректным учётом эффекта модуляции длины канала, (тезисы).	печатная КС 6 0	Семинар ФГУП «НПП «Пульсар» совместно с МНТОРЭС им. А.С. Попова «Вопросы использования САПР приборно-технологического моделирования при разработке СВЧ транзисторов на основе кремния, арсенида галлия и широкозонных полупроводников», г. Москва, 23 декабря 2009 г.	1 с.	В.О. Турин, А.В. Седов, Г.И. Зебрев, Б. Инигез, М.С. Шур,
46	Улучшенная компактная модель МОП-транзистора: анализ, реализация и развитие (тезисы).	печатная КС 6 0	Научная сессия НИЯУ МИФИ, Москва, 2010.	1 с.	В.О. Турин, А.В. Седов, Г.И. Зебрев, Б. Инигез, М.С. Шур
47	TCAD моделирование технологического	печатная	Научная сессия НИЯУ МИФИ-2010, Москва,	1 с.	А.В. Седов, В.О. Турин, А.М.

	процесса изготовления кремниевого вертикального МОП-транзистора с двойной диффузией (тезисы).	кет в Ф	МИФИ, 2010.		Цырлов
48	Моделирование микроэлектронного тензопреобразователя давления на основе КНС-структуры (тезисы).	печатная кет в Ф	Научная сессия НИЯУ МИФИ-2010, Москва, МИФИ, 2010.	1с.	З.П. Козил, О.М. Борисов, О.В. Деев, В.О. Турин, О.П. Перепелицын
49	Accurate incorporation of the channel-length modulation effect in the improved $\alpha$ -Si RPI-TFT compact model (тезисы).	печатная кет в Ф	International Symposium on Flexible Electronics 2010 (ISFE'10), Palma de Mallorca, Spain, April 11-14 2010.	1с.	V.O. Turin, A.V. Sedov, G.I. Zebrev, B. Iñiguez, and M.S. Shur
50	Extrinsic compact TFT model with correct account of positive differential conductance after saturation due to self-heating effect. (тезисы).	печатная кет в Ф	Third International Workshop on Compact Thin-Film Transistor (TFT) Modeling for Circuit Simulation (C-TFT). Tarragona, Spain. July 2 2010.	1с.	Valentin O. Turin, Gennady I. Zebrev, Benjamin Iñiguez, Michael S. Shur.
51	Improved RPI TFT compact model : extrinsic and with correct account of positive differential conductance after saturation. (тезисы).	печатная кет в Ф	MOS-AK/GSA ESSDERC/ESSCIRC Workshop "Frontiers of the Compact Modeling for Advanced Analog/RF Applications". Seville, Spain. September 17 2010.	1с.	V.O. Turin, G.I. Zebrev, B. Iñiguez, and M.S. Shur.
52	Моделирование явления саморазогрева в GaN HFET в программе TCAD Synopsys. (тезисы).	печатная кет в Ф	V научно-технический семинар ФГУП "НПП "Пульсар" и МНТОРЭС им. А.С. Попова "Практика применения тепловых моделей и расчетов при проектировании нового поколения СВЧ транзисторов и твердотельных модулей". г. Москва. 29 сентября 2010.	1с.	В.О. Турин, Зебрев Г.И., Дорофеев А.А.
53	Моделирование саморазогрева в	печатная	IX научно-техническая конференция	1 с.	В.О. Турин, Г.И. Зебрев, А.А.

	полевом транзисторе с AlGaN/GaN гетеропереходом. (тезисы).	нет в Ф	"Твердотельная электроника, сложные функциональные блоки РЭА", г. Звенигород. 1-3 декабря 2010		Дорофеев.
54	Моделирование кремниевого вертикального полевого транзистора с двойной диффузией. (тезисы).	печатная нет в Ф	53-ья Научная конференция МФТИ. Секция микроэлектроники. г. Зеленоград. 25 декабря 2010.	1 с.	И.С. Мартемьянов, В.О. Турин, В.В. Иванова, Г.И. Зебрев, А.М. Цырлов
55	Приборно-технологическое моделирование выходных характеристик GaN полевого транзистора с учётом явления саморазогрева. (тезисы).	печатная нет в Ф	Научная сессия НИЯУ МИФИ-2011, г. Москва. 24-30 января 2011.	1 с.	Турин В.О., И.С. Мартемьянов, Зебрев Г.И., Дорофеев А.А

Соискатель



Список верен:

Заведующий кафедрой "Физика"

В.С. Шоркин

Ученый секретарь ученого Совета

К.В. Подмастерьев

5 апреля 2011 г.

